

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 09-237938

(43)Date of publication of application : 09.09.1997

(51)Int.CI.

H01S 3/18

H01L 33/00

(21)Application number : 08-042711

(71)Applicant : SHARP CORP

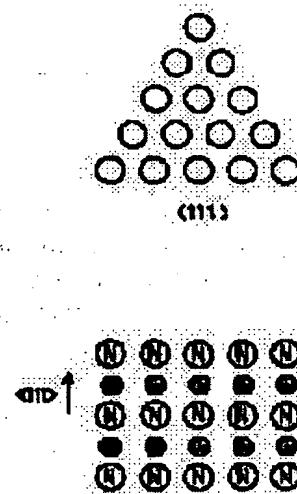
(22)Date of filing : 29.02.1996

(72)Inventor : TERAGUCHI NOBUAKI

**(54) III-V GROUP COMPOUND SEMICONDUCTOR DEVICE****(57)Abstract:**

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To form a single crystal having less crystal defects such as dislocation by using the (111) surface of a metal nitride having a rock salt structure of a nitride based III-V group compound semiconductor light-emitting element as a substrate.

**SOLUTION:** A single crystal is formed by adjusting the target composition of a Cr0.24Zr0.76N substrate by using a single metal nitride taking a rock salt structure so that a composition ratio of Cr and Zr may become 24:76 and performing reactive sputtering. A (111) is desirable as a crystal surface of the substrate material. When the uppermost surface layer of the (111) surface is terminated with nitride atoms, the uppermost surface layer is covered with crystallographically equivalent nitride atoms and the positions to be stuck by gallium atoms also become equivalent so as to continuously grow a GaN single of a good wurzite structure. Two kinds or more of metal nitrides are optionally combined so as to obtain a substrate material lattice-matching to a nitride system III-V group compound semiconductor thus allowing formation of a good single crystal.

**LEGAL STATUS**

[Date of request for examination] 05.02.2003

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

对証文件3

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-237938

(43)公開日 平成9年(1997)9月9日

(51)Int.Cl.<sup>6</sup>

H 0 1 S 3/18  
H 0 1 L 33/00

識別記号

庁内整理番号

F I

H 0 1 S 3/18  
H 0 1 L 33/00

技術表示箇所

C

審査請求 未請求 請求項の数3 O L (全 4 頁)

(21)出願番号

特願平8-42711

(22)出願日

平成8年(1996)2月29日

(71)出願人 000005049

シャープ株式会社

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

(72)発明者 寺口 信明

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ  
ャープ株式会社内

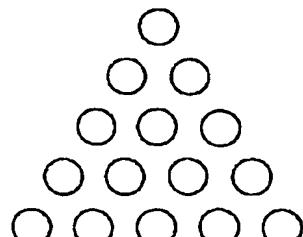
(74)代理人 弁理士 梅田 勝

(54)【発明の名称】 III-V族化合物半導体装置

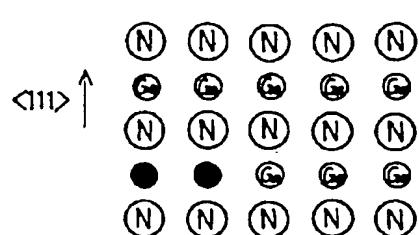
(57)【要約】

【課題】 硼化物系III-V族化合物半導体との格子不  
整が極めて小さくできる基板材料を提供する。

【解決手段】 硼化物系III-V族化合物半導体発光素  
子において、結晶構造として岩塙構造をとる金属窒化物  
の(111)面を基板として用いることを特徴とする。



(111)



1

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 壕化物系III-V族化合物半導体発光素子において、結晶構造として岩塩構造をとる金属塙化物の(111)面を基板として用いてなることを特徴とするIII-V族化合物半導体装置。

【請求項2】 前記基板としてCrScN混晶基板を用い、その上に塙化物系III-V族化合物半導体として少なくともAlGaNクラッド層が形成されてなることを特徴とする請求項1に記載のIII-V族化合物半導体装置。

【請求項3】 前記基板としてVYbN混晶基板を用い、その上に塙化物系III-V族化合物半導体として少なくともAlGaNクラッド層が形成されてなることを特徴とする請求項1に記載のIII-V族化合物半導体装置。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、塙化物系III-V族化合物半導体装置に関する。さらに詳しくは、塙化物系III-V族化合物半導体装置のための基板材料に関する。

## 【0002】

【従来の技術】これまで、AlN、GaN、InNなど塙化物系III-V族化合物半導体装置に用いられる基板としては、サファイア( $\text{Al}_2\text{O}_3$ )（特開平5-190903号公報）、あるいは炭化ケイ素(SiC)が検討されている。

## 【0003】

【発明が解決しようとする課題】前記の基板上に形成された塙化物系III-V族化合物半導体は、良好な単結晶を得ることができず、そのため、これを用いて発光素子を作製すると、レーザでは発振しない、LEDでは寿命が短いなどの問題があった。これは基板と化合物半導体との格子不整が大きな原因であるが、これまで塙化物系III-V族化合物半導体に格子整合した基板は見いだされていなかった。

【0004】例えば、従来 $\text{Al}_2\text{O}_3$ 基板の場合、GaNに対する格子不整は10%以上にもおよび、またSiC基板の場合も、GaN、AlNに対してそれぞれ3.5%、1.0%の格子不整を有している。

【0005】本発明の目的は、塙化物系III-V族化合物半導体との格子不整が極めて小さくできる基板材料を見いだすことである。

## 【0006】

【課題を解決するための手段】各種金属塙化物の基板を検討した結果、金属塙化物より成る基板を用いることにより、格子整合した基板が得られることを見いだした。

【0007】本発明の塙化物系III-V族化合物半導体装置は、結晶構造として岩塩構造をとる金属塙化物の(111)面を基板として用いることを特徴とする。

2

【0008】また、本発明の塙化物系III-V族化合物半導体装置は、前記基板として $\text{Cr}_{0.24}\text{Sc}_{0.76}\text{N}$ を用い、その上に塙化物系III-V族化合物半導体として少なくとも $\text{Al}_{0.1}\text{Ga}_{0.9}\text{N}$ クラッド層が形成されたことを特徴とする。

【0009】岩塩構造をとる単体の金属塙化物例としては表1のような材料がある。

## 【0010】

## 【表1】

10

金属塙化物	$a_{cubic}$	$a_{hex}$
CeN	5.011	3.54
CrN	4.140	2.93
DyN	4.905	3.47
ErN	4.839	3.42
EuN	5.014	3.55
GdN	4.999	3.53
HoN	4.874	3.45
LaN	5.301	3.75
LuN	4.766	3.37
NbN	5.151	3.64
PrN	5.155	3.65
PuN	4.905	3.47
ScN	4.440	3.14
SmN	5.048	3.57
TbN	4.933	3.49
ThN	4.200	3.68
TiN	4.235	3.99
TmN	4.809	3.40
UN	4.884	3.45
VN	4.128	3.92
YN	4.877	3.45
YbN	4.785	3.38
ZrN	4.610	3.26

20

【0011】ここで、表中の数値の単位は、オングストロームである。

【0012】基板材料の結晶面としては(111)面が好ましい。

30

【0013】これらの中に単体で塙化物系III-V族化合物半導体と格子整合するものが無い場合には、これらのうちの2種以上からなる混晶基板を用いてもよい。

## 【0014】

【発明の実施の形態】以下に、実施例を示す。

40

【0015】(実施例1)図1は、本発明の一実施例である塙化物系III-V族化合物半導体装置の概要を示す断面図である。1は、 $\text{Al}_{0.1}\text{Ga}_{0.9}\text{N}$ に格子整合した $\text{Cr}_{0.24}\text{Zr}_{0.76}\text{N}$ 基板、2はn型 $\text{Al}_{0.1}\text{Ga}_{0.9}\text{N}$ クラッド層( $\text{Nd}-\text{Na}=5 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ 、膜厚 $2 \mu\text{m}$ )、3は $\text{Ga}_{0.9}\text{In}_{0.1}\text{N}$ 活性層(膜厚 $20 \text{ nm}$ )、4はp型 $\text{Al}_{0.1}\text{Ga}_{0.9}\text{N}$ クラッド層( $\text{Na}-\text{Nd}=5 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ 、膜厚 $1 \mu\text{m}$ )、5はp型GaNコンタクト層( $\text{Na}-\text{Nd}=1 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ 、膜厚 $0.1 \mu\text{m}$ )、6はp型GaNコンタクト層5の上に形成した電極である。n型側の電極は、基板をそのまま電極として用いている。

50

【0016】 $\text{Cr}_{0.24}\text{Zr}_{0.76}\text{N}$ 基板の作製法としては、例えば、スパッタ膜のCrとZrの組成比が24:76となるようにターゲットの組成を調整し、ZrN基板の上に窒素あるいはアンモニア等のガスを用いて反応

性スパッタリングを行う方法等を用いることができる。  
【0017】この半導体発光素子の電流-電圧特性を図2に、発光スペクトルを図3に示す。金属窒化物を基板として用いた場合、従来のサファイア基板上の発光素子に比べて、約3倍の発光強度を有する素子が、作製可能となった。

【0018】次に、格子整合の取り方について説明する。

【0019】例えば $A_{10.2}Ga_{0.8}N$ 化合物半導体に対して格子整合した基板を得るには、以下のように行う。

【0020】表1は、岩塩構造をとる金属窒化物の格子定数 $a_{cubic}$ を表したものである。この格子定数をもとにして、

$$a_{hex} = a_{cubic} / \sqrt{2}$$

を用いて求めた(111)面の窒素原子間の距離(この距離がウルツ鉛構造の $a$ 軸の格子定数と対応する) $a_{hex}$ を合わせて表1に示している。また、窒化物系III-V族化合物半導体、 $A_1N$ ,  $GaN$ ,  $InN$ の格子定数を表2に示す。

【0021】

【表2】

化合物半導体	$a_{cubic}$	$a_{hex}$
$A_1N$	4.401	3.11
$GaN$	4.510	3.19
$InN$	5.018	3.55

【0022】ここで、表中の数値の単位はオングストロームである。

【0023】クラッド層として $A_{10.2}Ga_{0.8}N$ を用いた場合、 $a$ 軸の格子定数は、

$$a = 3.11 + (3.19 - 3.11) \times 0.8 = 3.174 \text{ \AA}$$

となる。この格子定数と同一の格子定数を持つことができる組み合わせとしては、これより小さい格子定数をもつもの例えばVNと、大きい格子定数をもつもの例えばYbNとの組み合わせが挙げられる。その組成は、YbNの組成比Xとすると、

$$3.174 = 2.92 + (3.38 - 2.92) \times X$$

これより

$$X = 0.55$$

となり、基板材料として $V_{0.45}Yb_{0.55}N$ が考えられる。

【0024】基板材料の結晶面としては(111)面が好ましく、(100)面、(110)面は結晶面としては適さない。これは、図4に示すように(111)面の最表面層を窒素原子でターミネートした場合、最表面層

10

は結晶学的に等価な窒素原子で覆われているため、例えればガリウム原子が付着する位置も結晶学的に等価となり、引き続いて良好なウルツ鉛構造のGaN単結晶が成長していく。しかしながら、(100)面、(110)面の場合、最表面層を窒素原子でターミネートした場合、ガリウム原子は、図5に示す結晶学的に異なる2つの位置に付着することが可能となる。したがって、基板直上では岩塩構造のGaNが成長しようとするが、岩塩構造は安定な結晶構造でないため閃亜鉛構造あるいはウルツ鉛構造のGaNへと遷移し、その結果、基板との界面で転位が生じてしまい、良好な単結晶成長が困難となる。

【0025】以上のように、表1から2種以上の金属窒化物を任意に組み合わせることによって、各種の窒化物系III-V族化合物半導体に格子整合する基板材料を得ることが可能となり、その結果、転位等の結晶欠陥の少ない良好な単結晶を得ることが可能となる。

【0026】

【発明の効果】本発明によれば、窒化物系III-V族化合物半導体発光素子において、窒化物系III-V族化合物半導体と格子整合した基板を用いることによって転位等の結晶欠陥の少ない良好な単結晶を得ることが可能となる。

【0027】また、金属窒化物は導電性があるため、基板そのものを電極として用いることができる。

【0028】さらに、基板そのものを電極として用いることができるため、素子の作製がサファイア基板上の場合よりも容易となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】実施例の窒化物系III-V族化合物半導体装置の断面図である。

【図2】実施例の窒化物系III-V族化合物半導体装置の電流-電圧特性を示す図である。

【図3】実施例の窒化物系III-V族化合物半導体装置の発光スペクトルを示す図である。

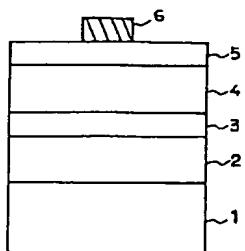
【図4】(111)面の原子配列を示す図である。

【図5】(100)及び(110)面の原子配列を示す図である。

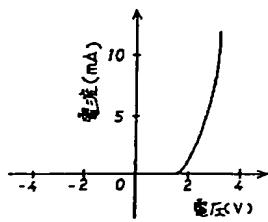
【符号の説明】

- 40 1  $A_{10.1}Ga_{0.9}N$ に格子整合した $Cr_{0.1}Sc_{0.9}N$ 基板
- 2 n型 $A_{10.1}Ga_{0.9}N$ クラッド層
- 3  $Ga_{0.9}In_{0.1}N$ 活性層
- 4 p型 $A_{10.1}Ga_{0.9}N$ クラッド層
- 5 p型GaNコンタクト層
- 6 p型電極

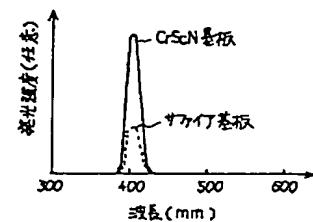
【図1】



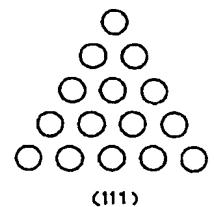
【図2】



【図3】



【図4】



【図5】

